

Сведения о ведущей организации

Полное наименование организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов Российской академии наук
Сокращенное наименование организации	ИПТМ РАН
Место нахождения	г. Черноголовка
Почтовый адрес	142432, Московская обл., Ногинский р-н, Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д. 6
Телефон, адрес электронной почты, сайт	(496) 524-40-58 general@iptm.ru, http://www.iptm.ru

Список основных публикаций сотрудников университета по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет

1. Пещерова С.М., Якимов Е.Б., Непомнящих А.И., Павлова Л.А., Феклисова О.В. Рекомбинационная активность границ раздела в мультикристаллическом кремнии // Физика и техника полупроводников. 2015. Т. 49, вып. 6. С.741-745.
2. Ершов П.А., Кузнецов С.М., Снигирева И.И., Юнкин В.А., Гойхман А.Ю., Снигирев А.А. Высокора разрешающая рентгеновская дифрактометрия с применением одномерных и двумерных преломляющих линз // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2015. № 6. С. 55-59.
3. Lyubomirskiy M.A., Snigireva I.I., Kuznetsov S.M., Yunkin V. A., Snigirev A.A. Hard X-ray single crystal bi-mirror // Optics Letters. 2015. Vol. 40, Iss. 10. P. 2205-2208.
4. Вергелес П.С., Якимов Е.Б. Влияние обратного напряжения на оптические свойства исходных и облученных электронным пучком в РЭМ светодиодов с множественными квантовыми ямами InGaN/GaN // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2015. № 9. С. 86-90.
5. Irzhak D.V., Knyasev M.A., Punegov V.I., Roshchupkin D.V. X-ray diffraction by phase diffraction gratings // J. Appl. Cryst. 2015. Vol. 48, Iss. 4. P.1159-1164.
6. Irzhak D.V., Roshchupkin D.V. X-ray diffraction on the X-cut of a $\text{Ca}_3\text{TaGa}_3\text{Si}_2\text{O}_{14}$ single crystal modulated by a surface acoustic wave // J. Appl. Phys. 2014. Vol. 115. P. 244903.
7. Карандашев В.К., Лейкин А.Ю., Жерноклеева К.В. Снижение матричного эффекта в ИСП-МС за счет оптимизации настроек ионной оптики // Журнал аналитической химии. 2014. Т. 69, № 1. С. 26-34.
8. Якимов Е.Б. Характеризация GaN и структур на его основе методами растровой электронной микроскопии // Ученые записки физического факультета Московского университета. 2014. Т. 1, № 2. С. 50-54.
9. Егоров В.К., Егоров Е.В., Афанасьев М.С., Возможности ионо-пучковых методов диагностики планарных структур // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2013. №7. С. 40-49.
10. Roshchupkin D.V., Ortega L., Plotitsyna O.A., Erko A.I., Zizak I., Irzhak D.V. X-ray diffraction study of surface acoustic waves and pseudo-surface acoustic waves propagation in $\text{La}_3\text{Ga}_{5.5}\text{Ta}_{0.5}\text{O}_{14}$ crystal // J. Appl. Phys. 2013. Vol. 113. P. 144909.
11. Шабельникова Я.Л., Якимов Е.Б. Скорость генерации неравновесных носителей заряда сфокусированным рентгеновским пучком // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2013. № 9. С. 53-56.
12. Рау Э.И., Дицман С.А., Зайцев С.В., Лермонтов Н.В., Лукьянов А.Е., Купреенко С.Ю. Анализ формул для расчета основных характеристик отраженных электронов и сравнение с экспериментальными результатами // Известия РАН. Серия физическая. 2013. Т. 77, № 8. С. 1050-1058.

13. Вергелес П.С., Шмидт Н.М., Якимов Е.Б. Влияние облучения электронным пучком в РЭМ на катодoluminesценцию и наведенный ток в InGaN/GaN светодиодах с заглубленной активной областью // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2012. № 11. С. 22-26.
14. Николайчик В.И., Соболев Б.П., Запорожец М.А., Авилов А.С. Влияние электронного облучения на фториды щелочно-земельных элементов (CaF₂, SrF₂ и BaF₂) // Известия РАН. Сер. физическая. 2012. Т. 76, № 9. С. 1143-1148.
15. Леонов А.В., Мокрушин А.Д., Омеляновская Н.М. Особенности подвижности электронов в тонком слое кремния в структуре диэлектрик-кремний-диэлектрик // Физика и техника полупроводников. 2012. Т. 46, вып. 4. С. 494-499.